

а 2003 0081

Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности к способам получения фотонных кристаллов.

Способ получения фотонного кристалла включает нанесение маски на одну из граней диэлектрического или полупроводникового кристалла, при этом маска выполнена в виде решетки с отверстиями, которые расположены в рядах с одинаковым шагом, затем осуществляют имплантацию ионов высокой энергии в каждое отверстие маски в четырех направлениях и электрохимическое травление. Новизна изобретения состоит в том, что при осуществлении имплантации каждое направление ионов образует угол  $45^\circ$  относительно нормали к поверхности грани кристалла, а углы между направлениями ионов равны  $90^\circ$ .

П. формулы: 1

Фиг.: 1